

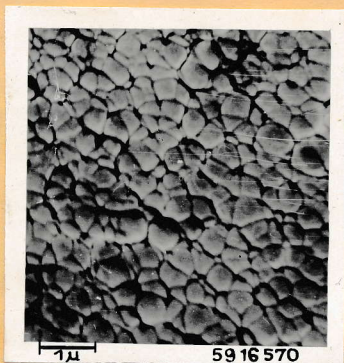
5916568



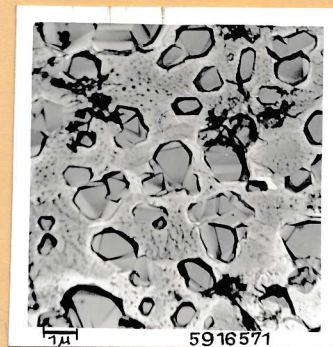
5916569

Abb.15 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht, die im Hochvakuum auf eine Kohlefolie gedampft wurde. Durch Elektronenbeschuß umgewandelt.

Abb.16 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht, die im Hochvakuum auf eine Kohlefolie gedampft wurde. Durch Elektronenbeschuß stark umgewandelt.



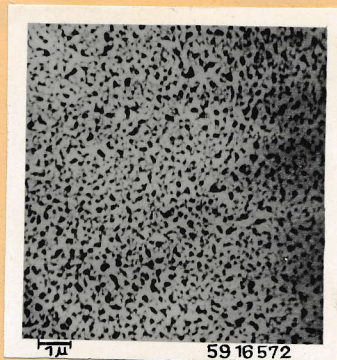
5916570



5916571

Abb.17 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht (Kohleabdruck), die im Hochvakuum hergestellt wurde.

Abb.18 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht (Kohleabdruck), die im Hochvakuum hergestellt und bei 250°C umgewandelt wurde.



5916572

Abb.19 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht, die bei einem Argongasdruck von 2,5 Torr auf eine Kohlefolie gedampft wurde. 1. Stadium der Umwandlung im Elektronenmikroskop.



Benennung Schaffung von Grundlagen zur Herstellung von Halbleiterschichten

Blatt 46
von 49 Blatt

Ausgabe Tag Name

Nr. 97 / F 9 - 502 / 8

VP Nr.

P Nr.

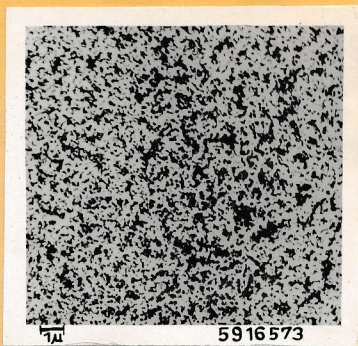


Abb.20 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht, die bei einem Argongasdruck von 2,5 Torr auf eine Kohlefolie gedampft wurde. 2. Stadium der Umwandlung im Elektronenmikroskop.

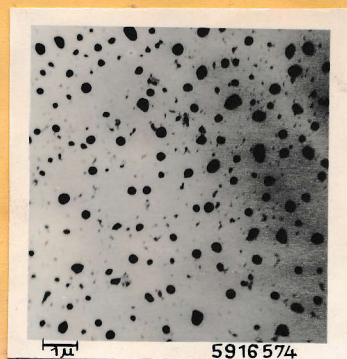


Abb.21 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht, die bei einem Argongasdruck von 2,5 Torr auf eine Kohlefolie gedampft wurde. Letztes Stadium der Umwandlung im Elektronenmikroskop.

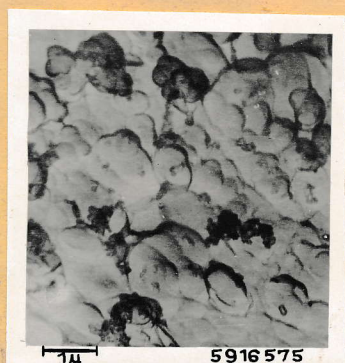


Abb.22 Übermikroskopaufnahme von rotem Sb_2S_3 -Pulver (Kohleabdruck).



Abb.23 Übermikroskopaufnahme von schwarzem Sb_2S_3 -Pulver (Kohleabdruck).



Abb.24 Übermikroskopaufnahme einer Sb_2S_3 -Schicht (Kohleabdruck) von einem Endikon mit einem Signal von $0,07 \mu A$ bei 50 lx auf der Fotokathode.



VEB
Werk für
Fernmelde-
wesen

Benennung Beschaffung von Grundlagen zur Blatt 47
Herstellung von Halbleiterschichten von 49 Blatt

Ausgabe Tag Name

Nr. 97 / F 9 - 502 / 8

VP
Nr.

P
Nr.